

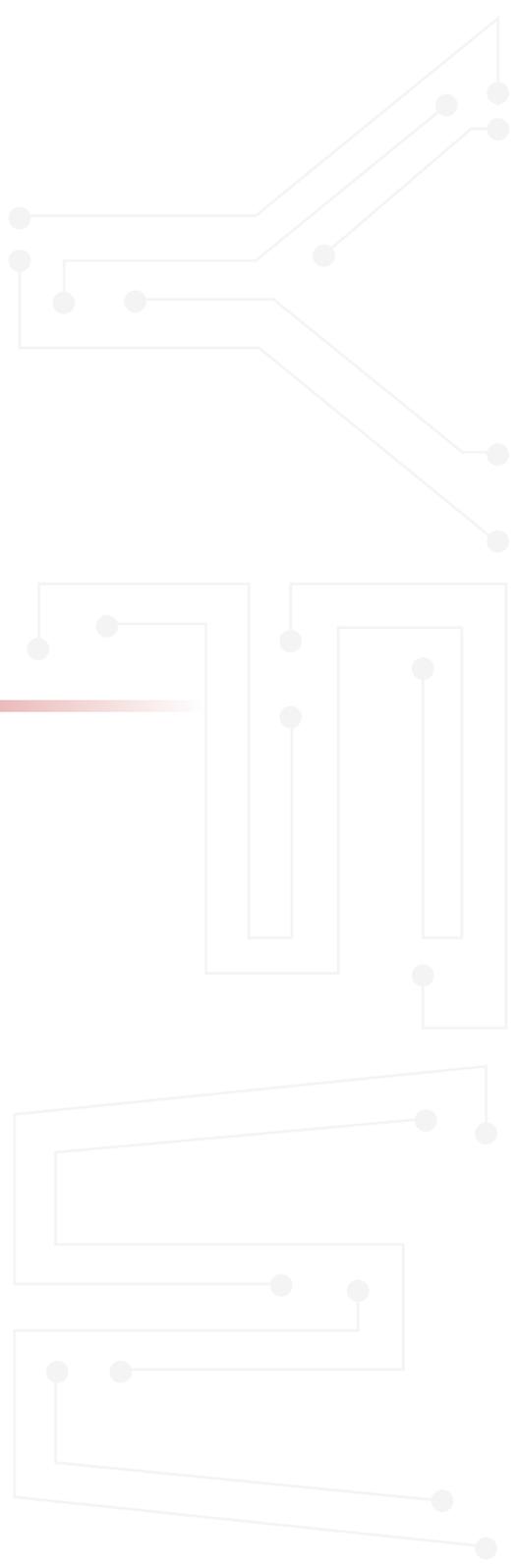


# YFD009

---

## 芯片规格书

YFW芯片规格书



# YFD009

## 芯片规格书

YFD009为一氮化镓KU波段高功率放大器，采用0.15umGaN工艺制作。典型输出指标如下。

频率:12GHz-18GHz;

功率增益:18dB;

饱和输出功率:44dBm@Pin=26dBm;

供电电压:双电源, 负压-1.6V, 正压28V;

功率附加效率:32%。

芯片外形接口如图1所示。

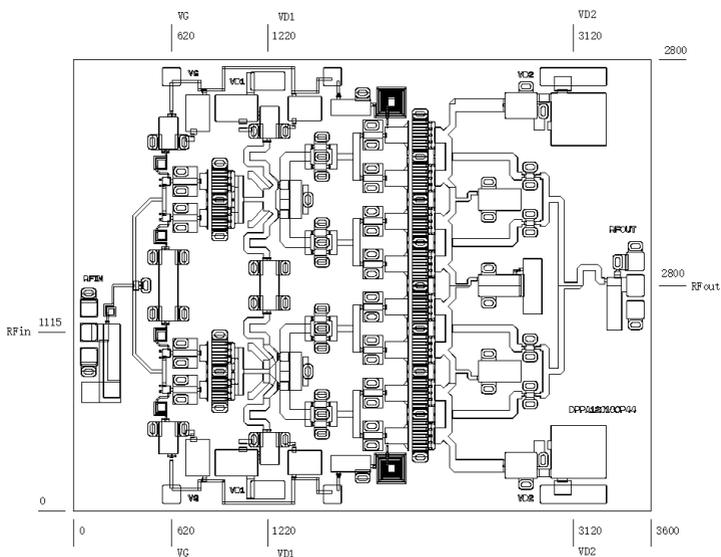


图1 芯片外形接口图

# YFD009

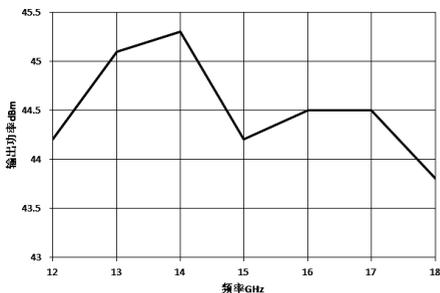
## 芯片规格书

芯片接口说明如表1所示。

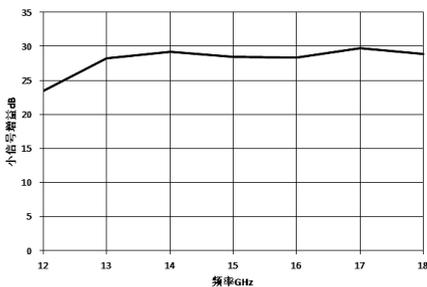
端口名称	端口定义	说明
RFin	射频输入端口	射频输入, 内置隔直电容
RFout	射频输出端口	射频输出, 内置隔直电容
VG	栅极供电端口	电压-1.6V
VD1	漏极供电端口1	电压28V
VD2	漏极供电端口2	电压28V

表1 端口定义

测试结果如图2所示。测试条件:  $P_{in}=26\text{dBm}$ ,  $VD1=VD2=28\text{V}$ ,  $VG=-1.6\text{V}$ , 脉宽  $1\text{ms}$ , 占空比2%, 漏极调制。



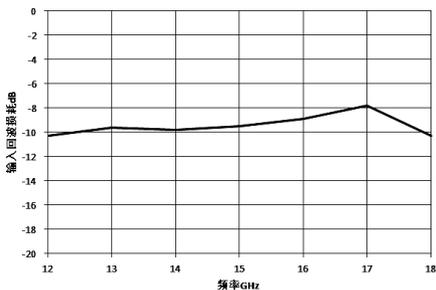
输出功率



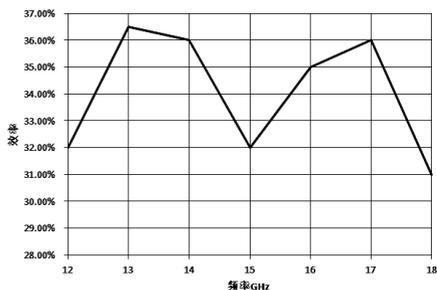
小信号增益

# YFD009

## 芯片规格书



输入回波损耗



功率附加效率

装配图如图3所示。

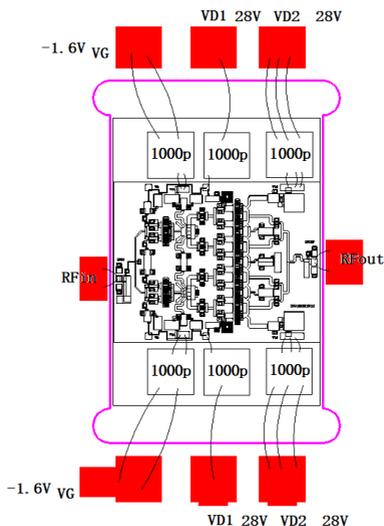


图3 装配示意图

\*漏极调制电源需与芯片供电端尽量接近，以5cm之内为宜。